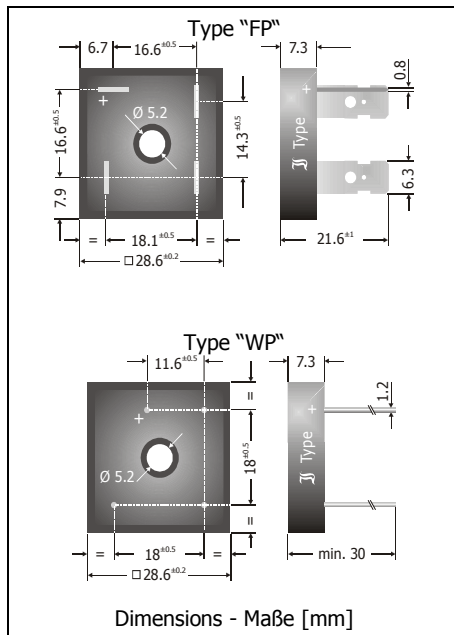


KBPC3500FP ... KBPC3514FP, KBPC3500WP ... KBPC3514WP
**Silicon-Bridge-Rectifiers
Silizium-Brückengleichrichter**

Version 2013-04-12



Nominal current
Nennstrom 35 A

Alternating input voltage
Eingangsschweissspannung 35...900 V

Plastic case with alu bottom
Plastikgehäuse mit Alu-Boden 28.6 x 28.6 x 7.3 [mm]

Terminals
Anschlüsse FP = Fast-on ¹⁾
WP = Wire ¹⁾

Weight approx.
Gewicht ca. 17 g

Compound has classification UL94V-0
Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging bulk
Standard Lieferform lose im Karton



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangsschweissspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrespannung V_{RRM} [V] ²⁾
KBPC3500FP/WP	35	50
KBPC3501FP/WP	70	100
KBPC3502FP/WP	140	200
KBPC3504FP/WP	280	400
KBPC3506FP/WP	420	600
KBPC3508FP/WP	560	800
KBPC3510FP/WP	700	1000
KBPC3512FP/WP	800	1200
KBPC3514FP/WP	900	1400

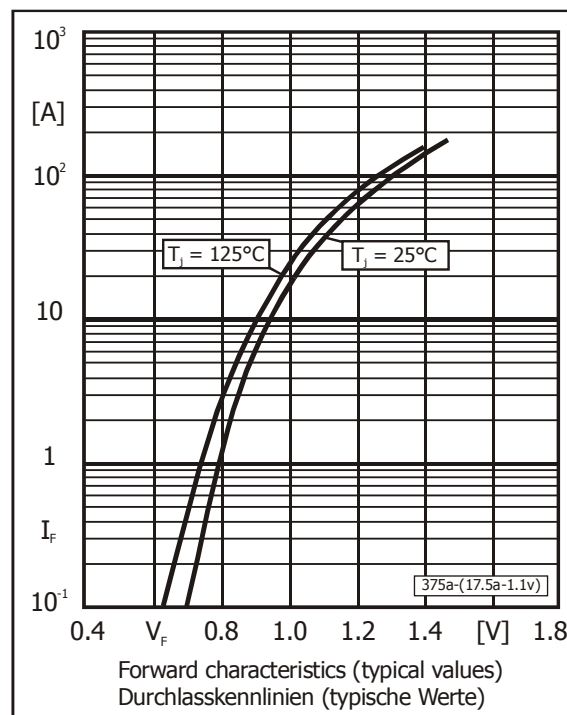
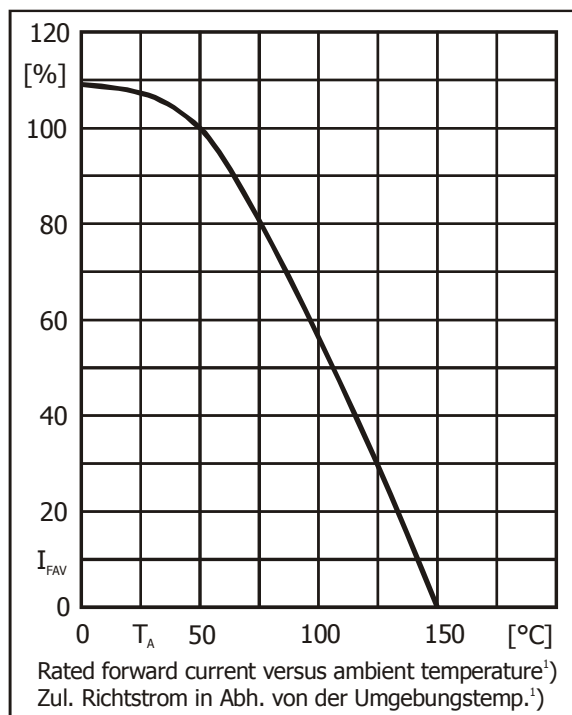
1 Solderable per MIL-STD-202, Method 208, terminal temperature not exceeding 260°C
Lötbar gemäß MIL-STD-202, Methode 208, Temperatur der Anschlussdrähte nicht höher als 260°C
2 Valid per diode – Gültig pro Diode

Maximum ratings
Grenzwerte

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	80 A ¹⁾
Peak forward surge current 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	KBPC3500FP/WP ... KBPC3510FP/WP KBPC3512FP/WP ... KBPC3514FP/WP	$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM} 375/400 A 300/330 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	660 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

Characteristics
Kennwerte

Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	35 A 28 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 17.5 \text{ A}$	V_F	< 1.1 V ²⁾
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			V_{ISO}	> 2500 V
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 1.5 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		10-32 UNF M5		18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm



1 Valid, if the temperature of the case is kept to $T_C = 120^\circ\text{C}$ – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf $T_C = 120^\circ\text{C}$ gehalten wird
2 Valid per diode – Gültig pro Diode